

# 用于0vββ实验的极低超导转变边缘TES光热探测

## 系统研发进展

吕沙沙 江建勇 张建杰 张翼飞 刘舟慧 郑昊哲 张少君 刘圆圆

#### 北京师范大学

中国科学院高能物理研究所

2023年5月7日-12日

第二届地下和空间粒子物理与宇宙物理前沿问题研讨会





- □ 极低超导转变边缘传感器TES制备进展
- □ 基于LMO-TES系统本底甄别与荧光输运过程模拟进展
- □ 总结和计划







#### 口低温晶体量热器在0vββ探测中的应用





CUPID-Mo experimental geometry showing (Left) the CUPID-Mo towers mounted in the EDELWEISS cryostat and single detector module (Right) with  $Li_2MoO_4$  crystal, PTFE clamps, Ge thermistor working as heat sensor, Si heater for response stabilization and Cu holder. The Ge light detector is seen through the  $Li_2MoO_4$  crystal.

CUPID

 高能量分辨率、高探测效率、核素选择灵活等优势
 实现高时间分辨率、高能量分辨率且易于大规模读出的光热双探测 读出技术,已成为下一代0vββ探测实验的关键核心问题之一



#### TES研究背景

□ 超导转变边缘传感器TES光热双读出

Silicon-on-Sapphire light detector

CaWO<sub>4</sub>

- 基于时间响应、能量分辨率、大规模读出需求,探索超导转 变边缘探测器的新技术。
- ◆ 超导转变边缘探测器主体为偏置在超导致正常态转变区内的 超导薄膜,利用其陡峭的R-T关系测量热量沉积,是一种单 光子探测器。
- ◆ 目前尚未用至0vββ 实验。







# TES研究背景

- □ CUPID-Mo TES光热双读出
- ◆ 压低 2vββ 衰变堆叠本底: 100Mo 的 2vββ 半衰期较短,其衰变堆叠产生的叠加信号成为 0vββ 信号的主要本底来源。利用 TES(时间分辨率 μs 量级)可区分堆叠事件进而压低 2vββ 本底, 根据所要达到的本底水平计算出得到 TES 热探测器的时间分辨和能量分辨要求。
- ◆ 扣除  $\alpha$  粒子本底:利用光热信号比值和信号衰减时间构建有效区分  $\alpha$  粒子本底与  $\beta/\gamma$ 信号 的物理模型,进而扣除 α本底,并给定TES 光子探测器的能量下阈和分辨率要求。





#### 极低超导转变边缘传感器TES制备进展





#### □ TES薄膜制备及测试

#### AlMn合金薄膜

- ◆ 定制了多种Al/Mn不同比例的靶材,研究靶材、 薄膜厚度、烘烤温度对Tc的显著影响
- ◆确定Tc<50mK所需靶材
- ◆ 通过摸索溅射参数,实现Tc~10-20mK目标

#### W薄膜

- ◆ 摸索功率、厚度、气压等溅射参数影响,利用 退火实验,实现α-W相薄膜的制备
- ◆ 优化参数,实现Tc~10-20mK目标







#### <u>CJPL-BNU</u> □ AIMn TES薄膜制备及测试

#### ◆薄膜厚度(180nm, 220nm)

#### ◆ 薄膜烘烤温度影响

溅射功率 (W)	厚度 (nm)	烘烤温度 (℃)	Tc (mK)	ΔT (mK)
100	~220	205	57.2↓ 57.6↑	0.4
		210	83.3↓ 83.7↑	2.3
		215	91.6↓ 92.0↑	2.4
		225	134↓ 135↑	8
		235	203.5↓ 204↑	15
		255	334↓ 337↑	15
		265	352↓↑	16
		275	351.4↓ 353.5↑	12



#### 180nm薄膜烘烤温度186~192℃

溅射功率 (W)	厚度 (nm)	烘烤温度 (℃)	Tc (0.5Rn) (mK)	Rn (mΩ)
100	~ 180	186	21.6↓ 23.7↑	92
		188	30.9↓ 31.0↑	88
		190	36.8↓ 37.0↑	82
		192	38.2↓ 38.5↑	68



□ AlMn TES薄膜制备及测试

#### ◆降温过程中Tc基本固定

◆升温过程加热器工作电流会影响AlMn薄膜Tc的测试,测得温度不准,Tc与起 点温度(从低温升到高温测转变的起点)相关,采取低速率控温





#### □ 20mK以下AlMn TES薄膜测试

磁场影响低Tc AlMn薄膜,有地磁,进行消磁处理

Cu盒, 180nm, 182°C/10分钟 磁场电流 磁场强度 Ar压强 Tc (0.5Rn) AlMn衬底 **B0-B1(G)** 外加磁场——线圈N=20, I=-0.2A, 亥姆霍兹线 (mTorr) **(A)** (**mK**) DR 线圈1 制冷机 圈,直径50cm,距离25cm 15.0 13.0 0.144 -0.3 测试电流正弦信号, 0.5mV, 串联电阻1000Ω 25cm 100W 垂直薄膜方向磁场B<sub>0</sub>为0.36G,电流产生磁场B<sub>1</sub> 1um SiN 5mTorr **16.8**↓ **16.0**<sup>↑</sup> -0.4 0.072 线圈2 BO 182°C/10min 发生变化 **18.0** | **17.1**<sup>↑</sup> -0.5 0



AlMn薄膜Tc对加热器控制电流、测试电流、外部磁场均敏感,Tc进入20mK





# ◆磁控溅射制备厚度~150nm的多晶W薄膜,XRD晶相测试主要为β-W ◆快速退火参数调控,得到主要为α-W薄膜,进一步需调控薄膜电阻





#### TES制备进展:探测器热电响应的建模

□ TES探测器热电响应的建模

#### 利用COMSOL根据已知文献模型对仿真过程进行梳理和检验

- ◆ 构建光子探测器模型,根据已有文献基础 TES detector st 对电场、温度分布各参数进行确认
- ◆ 施加能量脉冲温度响应
  ◆ 弱热链接支撑结构热导G的仿真
- Si
   Heater
   Nb Bonding Pad

   Heater
   Image: Si
   Si

   Image: Si
   Image: Si
   Image: Si

   Image: Si
   Image: Si
   Imag



Thermal conductance	Simulation	Thermal conductance	Simulation
$G (= nKT^{n-1})$	136.5 pW/K	$G\left(=4\frac{C\nu lSA}{3L}\right)$	144.2 pW/K
$G'\left(=\frac{C}{\tau}\right)$	123.6 pW/K	$G'(=P/(T-T_b))$	133.7 pW/K



#### TES制备进展:读出系统搭建

#### SQUID进行读出,在复旦大学稀释制冷机上 调试安装,最终进驻CJPL









#### 基于LMO-TES系统本底甄别与荧光输运过程模拟进展





#### 基于LMO-TES系统本底甄别与荧光输运过程模拟进展

堆积事件甄别目标:抑制<sup>100</sup>Mo的2vββ堆积事件本底

LMO的 0vββ 衰变 Q 值为 3034 keV,本底来源主要为2vββ 衰变堆叠和 α 粒子本底
 利用脉冲形状和相关特征量进行甄别

◆过阈时间算法

- ◆定阈值法: 计算过阈时间电路不随时间变化
- ◆动态阈值法:计算过阈时间电路根据脉冲形状 随时间变化







◆分别产生单信号和堆积信号 样本,计算每个信号在定阈值 下的过阈时间

**CJPL - BNU** 

甄别过程

NICIE

ERSI

BA IV

◆根据单信号过阈时间分布计 算甄别堆积信号的过阈时间范 围,探究不同信噪比下的甄别 效率变化

定阈值法在信噪比为30的情况 下可以达到78.5%

动态阈值法在同样信噪比下甄 别效率达到95.0%







#### 基于LMO-TES系统本底甄别与荧光输运过程模拟进展

#### □ 荧光输运过程模拟

#### ◆根据探测器结构建立光学模型

- 反射层:表面反射率
- LMO晶体: 折射率、表面反射率、吸收长度
- 硅片:表面反射率和吸收率
- TES: 表面反射率和吸收率

#### ◆仿真荧光在光子探测器硅片表面的沉积分布 及总量

- 表面光源/格点光源输入(以Geant4模拟得到的 LMO晶体内荧光分布及强度)
- 以光子探测器硅表面吸收到的荧光为输出

◆研究不同反射参数及布局对光子探测器接收 到光子总量的影响

• 以总量最大为最优布局







#### ◆ 光探测器抗反射层计算

	n <sub>1(antiref.)</sub>	n <sub>2(LD)</sub>	Reflectivity
1		Si(4.235)	37%
3	SiO <sub>2</sub> (1.4599)	Si(4.235)	7.2%
4	SiO(1.9785)	Si(4.235)	0.039%
7	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> (2.0319)	Si(4.235)	0.09%

#### ◆ 光源在晶体内部不同位置引起的光学 吸收效率模拟



最重要因素:与晶体的直线距离,距离越近,光效率越高 Y轴光效率差距较大,距离越近,效率提高越快 X轴光效率接近(-5%),中心点(0,0)光效率最高 Z轴光效率接近(+1%),远离中心点,靠近面外侧(有 反射层的情况下),光效率最高





AlMn薄膜Tc进入20mK,在20mK以内测试发现对测试电流、外部磁场等均敏感 优化W超导薄膜制备,测量不同制备参数下Tc,使其在 10-20 mK 温区稳定工作。 □模拟仿真

构建物理模型,开展LMO-TES能量沉积、荧光产生和传输过程仿真。 □TES探测器优化设计

接入GEANT4能量沉积数据,结合基础热电仿真得到温度、电流等响应情况,确 立符合要求的探测器模型参数。获得TES探测器优化设计方案,开展版图设计, 进行TES探测器表征和能量刻度测试。



# 谢谢各位专家

### 北京师范大学 吕沙沙